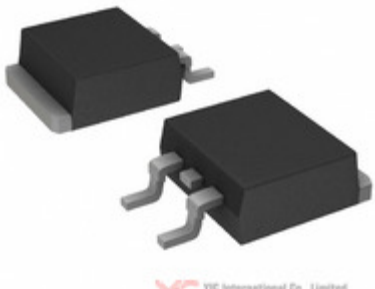

	<h2 style="color: red;">SQD50N05-11L_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQD50N05-11L_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 50V 50A TO252
	Datenblätter:  SQD50N05-11L_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	





Spezifikationen

Teilenummer	SQD50N05-11L_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 50V 50A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 45A, 10V
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	SQD50N05-11L-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2106pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	50V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 50V 50A (Tc) 75W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SQD50N05-11L_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQD50N05-11L_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQD50N05-11L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQD50N05-11L_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQD50N05-11L-GE3 V SQD50N05-11L-GE3 V</p>	 <p>SQD50N04-5M6_T4GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 50A TO252AA</p>	 <p>SQD50N05-11L VISHAY SQD50N05-11L VISHAY</p>	 <p>SQD50N06-09L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 50A</p>
 <p>SQD50N06-09L-GE3 VISHAY SQD50N06-09L-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQD50N05-11 VISHAY SQD50N05-11 VISHAY</p>	 <p>SQD50N05-11L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 50V 50A TO252</p>	 <p>SQD50N06-09L VISHAY SQD50N06-09L VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQD50N05-11L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQD50N05-11L_GE3 Datenblatt	SQD50N05-11L_GE3-Datenblätter	SQD50N05-11L_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQD50N05-11L_GE3
SQD50N05-11L_GE3 Electronic	SQD50N05-11L_GE3-Komponenten	SQD50N05-11L_GE3-Verteiler	SQD50N05-11L_GE3-Bild	SQD50N05-11L_GE3-Teil
SQD50N05-11L_GE3 Preis	SQD50N05-11L_GE3 Hersteller	SQD50N05-11L_GE3 Bild	SQD50N05-11L_GE3 Aktie	SQD50N05-11L_GE3 Inventar
SQD50N05-11L_GE3 Neu	SQD50N05-11L_GE3 Original	SQD50N05-11L_GE3 garantiert	SQD50N05-11L_GE3 RFQ	SQD50N05-11L_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited